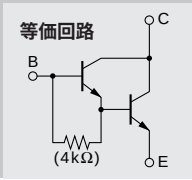
ダーリントン 2SD2017



シリコンNPN三重拡散プレーナ型トランジスタ

用途：ソレノイド、リレー、モータ駆動、一般用

■絶対最大定格 (Ta＝25℃)

記　号	規格値	単位
V_{CBO}	300	V
V_{CEO}	250	V
V_{EBO}	20	V
I_C	6	A
I_B	1	A
P_C	35(Tc＝25℃)	W
Tj	150	℃
Tstg	−55〜＋150	℃

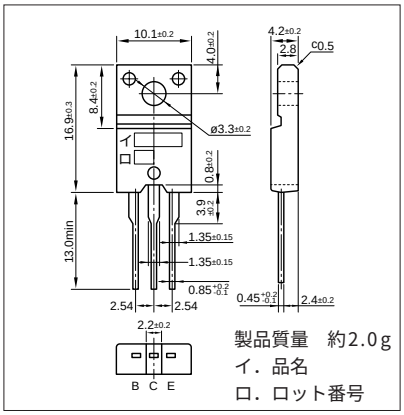
■電気的特性 (Ta＝25℃)

記　号	試験条件	規格値	単位
I_{CBO}	V_{CB}＝300V	100max	μA
I_{EBO}	V_{EB}＝20V	10max	mA
$V_{(BR)CEO}$	I_C＝25mA	250min	V
h_{FE}	V_{CE}＝2V, I_C＝2A	2000min	
$V_{CE(sat)}$	I_C＝2A, I_B＝2mA	1.5max	V
$V_{BE(sat)}$	I_C＝2A, I_B＝2mA	2.0max	V
f_T	V_{CE}＝12V, I_E＝−1A	20typ	MHz
C_{OB}	V_{CB}＝10V, f＝1MHz	65typ	pF

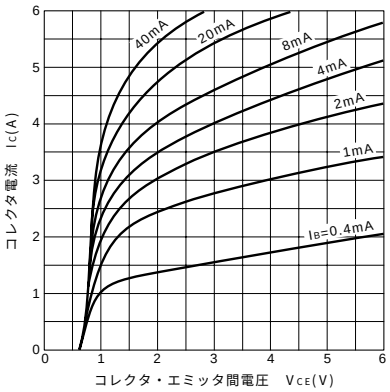
■代表的スイッチング特性（エミッタ接地）

V_{CC} (V)	R_L (Ω)	I_C (A)	V_{BB1} (V)	V_{BB2} (V)	I_{B1} (mA)	I_{B2} (mA)	ton (μs)	tstg (μs)	tf (μs)
100	50	2	10	–5	5	–10	0.6typ	16.0typ	3.0typ

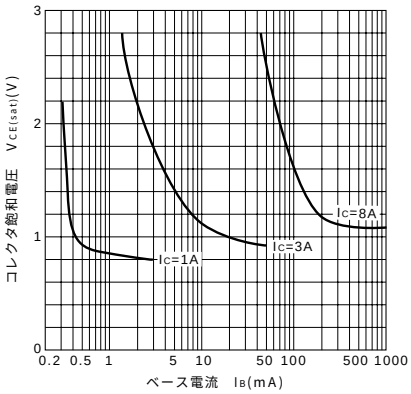
外形図　FM20(T0220F)



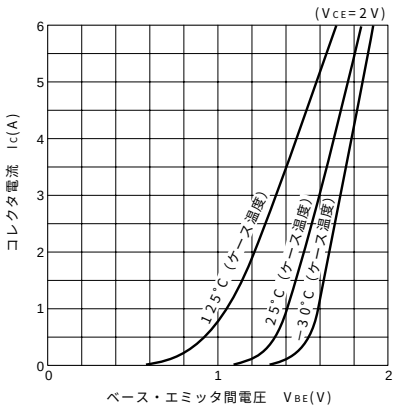
I_C−V_{CE}特性（代表例）



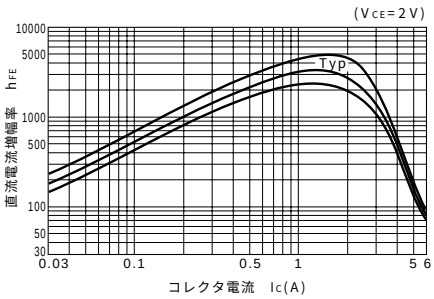
V_{CE}(sat)−I_B特性（代表例）



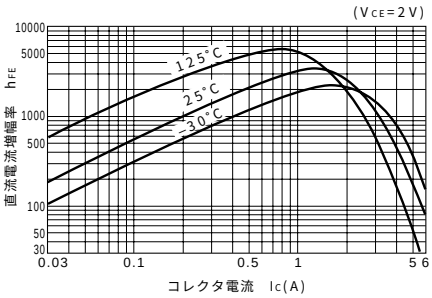
I_C−V_{BE}温度特性（代表例）



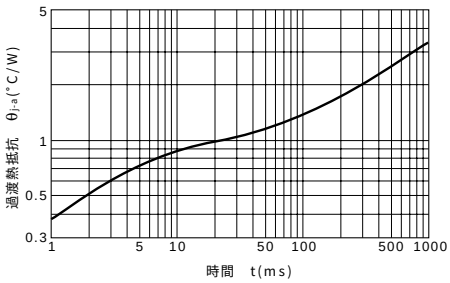
h_{FE}−I_C特性（代表例）



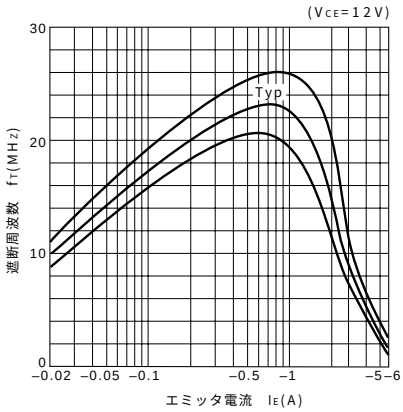
h_{FE}−I_C温度特性（代表例）



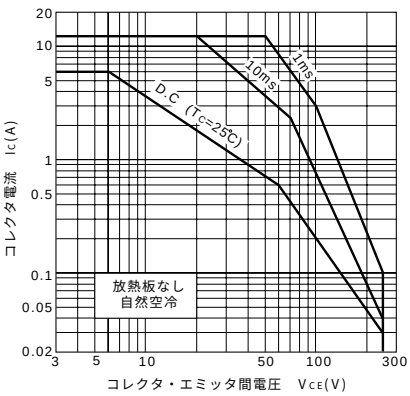
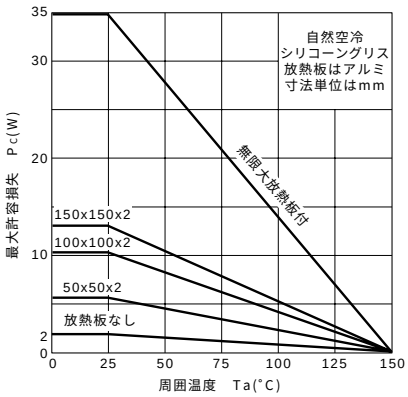
$\theta_{j\text{-}a}$−t特性



f_T−I_E特性（代表例）



ASO曲線（単発パルス）



Pc−Ta定格